

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

VERSION CORRIGÉE

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international(43) Date de la publication internationale
29 juillet 2004 (29.07.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/064132 A1(51) Classification internationale des brevets⁷ :
H01L 21/20, 21/18, 21/762, 21/58[FR/FR]; Lotissement Le Chateau, CIDEX 19 A, F-38190
Bérin (FR).(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2003/003590(74) Mandataire : SANTARELLI; 14, avenue de la Grande
Armée, B.P 237, F-75822 Paris Cedex 17 (FR).(22) Date de dépôt international :
4 décembre 2003 (04.12.2003)(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ,
DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW,
MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Langue de dépôt : français

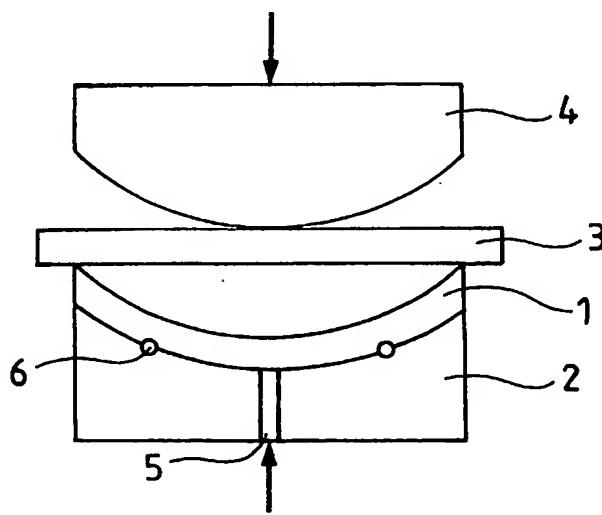
(84) États désignés (régional) : brevet ARIPO (BW, GH, GM,
KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet
eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,
TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(26) Langue de publication : français

Publiée :
— avec rapport de recherche internationale

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD OF PRODUCING A COMPLEX STRUCTURE BY ASSEMBLING STRESSED STRUCTURES

(54) Titre : PROCEDE DE REALISATION D'UNE STRUCTURE COMPLEXE PAR ASSEMBLAGE DE STRUCTURES
CONTRAINTEES

(57) Abstract: The invention relates to a method of producing a complex microelectronic structure, in which two basic microelectronic structures (1, 3) are assembled at the two respective connecting faces (3) thereof. The invention is characterised in that, before assembly, a difference is created in the tangential stress state between the two faces to be assembled, said difference being selected such as to produce a pre-determined stress state within the assembled structure under given conditions in relation to the assembly conditions.

(57) Abrégé : Procédé de réalisation d'une structure microélectronique complexe selon lequel on assemble deux structures microélectroniques élémentaires (1,3) par deux faces respectives de liaison (3), caractérisé en ce que, avant assemblage, on crée une différence d'état de contraintes tangentielles entre les deux faces à assembler, cette différence étant choisie en sorte d'obtenir au sein de la structure assemblée un état de contraintes prédéterminé dans des conditions données par rapport aux conditions d'assemblage.

WO 2004/064132 A1